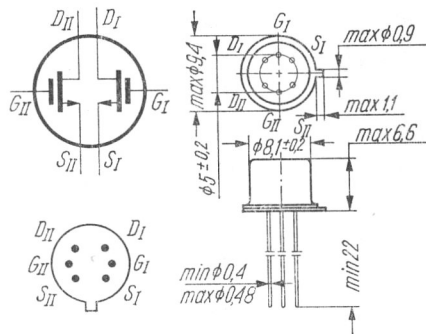


KFZ52



Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: TESLA

Wykonanie: podwójny tranzystor polowy MOS, kanał typu N (KF520+KF520), system odizolowany od obudowy

Zastosowanie: wzmacniacze z rezystancją wejściową rzędu $10^6 \Omega$

Rys. 1-804. KFZ52

Wartości charakterystyczne¹⁾

I_{D50}	0,01	μA	przy $U_{DS} = 10 \text{ V}$, $-U_{GS} = 25 \text{ V}$
U_{D50}	30	V	przy $I_D = 1 \mu\text{A}$, $-U_{GS} = 30 \text{ V}$
I_D	1 ÷ 3	mA	przy $U_{DS} = 10 \text{ V}$, $U_{GS} = 0$
y_{21e}	300	μS	przy $U_{DS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$
R_{we}	10^{13}	Ω	
$-U_T$	20	V	przy $U_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 10 \mu\text{A}$
y_{21I}/y_{21II}	0,9 ÷ 1		przy $U_{DS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$
U_{GS1}/U_{GSII}	0,6 < 2	V	przy $U_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 1,5 \text{ mA}$
$I_{D1}-I_{DII}$	0,1	mA	przy $U_{DS} = 10 \text{ V}$, $U_{GS} = 0$, $t = 20 \div 100^\circ\text{C}$
I_{D50}	3	μA	przy $U_{DS} = 10 \text{ V}$, $U_{GS} = -25 \text{ V}$ $t_{amb} = 125^\circ\text{C}$
c_{11e}	7	pF	przy $U_{DS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ MHz}$
r_{22e}	18	k Ω	
c_{22e}	7	pF	
c_{12e}	1,5	pF	
r_{11e}	200	k Ω	przy $U_{DS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$, $f = 10 \text{ MHz}$
c_{11e}	7	pF	
r_{22e}	15	k Ω	
c_{22e}	7	pF	
r_{12e}	200	k Ω	przy $U_{DS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$, $f = 30 \text{ MHz}$
c_{12e}	1,5	pF	
r_{11e}	33	k Ω	
c_{11e}	7	pF	
r_{22e}	8	k Ω	przy $U_{DS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$, $f = 50 \text{ MHz}$
c_{22e}	7	pF	
r_{12e}	40	k Ω	
c_{12e}	1,5	pF	
r_{11e}	10	k Ω	przy $U_{DS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$, $f = 50 \text{ MHz}$
c_{11e}	7	pF	
r_{22e}	5	k Ω	
c_{22e}	7	pF	
r_{12e}	20	k Ω	przy $U_{DS} = 15 \text{ V}$, $I_D = 5 \text{ mA}$, $f = 50 \text{ MHz}$
c_{12e}	1,5	pF	
C_{11e}	8	pF	

KFZ52

$\frac{\Delta I_D}{I_D} \cdot 100$	-0,15	%/°C	przy $I_D = 3 \text{ mA}$
	0	%/°C	przy $I_D = 1,5 \text{ mA}$
	+0,15	%/°C	przy $I_D = 0,5 \text{ mA}$
U_n	2,4	$\mu\text{V}/\text{Hz}^{1/2}$	przy $U_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ mA}$, $f = 10 \text{ Hz}$
U_n	0,25	$\mu\text{V}/\text{Hz}^{1/2}$	przy $U_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ mA}$, $f = 1 \text{ kHz}$
U_n	0,09	$\mu\text{V}/\text{Hz}^{1/2}$	przy $U_{DS} = 10 \text{ V}$, $I_D = 3 \text{ mA}$, $f = 10 \text{ kHz}$

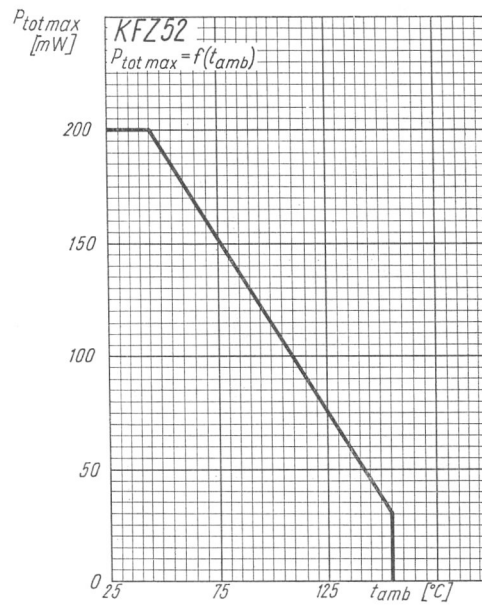
Wartości graniczne¹⁾

$U_{DS \text{ max}}$	30	V	$P_{tot \text{ max}}$	200 ³⁾	mW
$U_{GS \text{ max}}$	± 70 ²⁾	V	$t_{j \text{ max}}$	175	°C
$I_{D \text{ max}}$	20	mA	t_{stg}	-65 ÷ +175	°C

¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$

²⁾ $U_{DS} = 10 \text{ V}$

³⁾ $t_{amb} = 45^\circ\text{C}$



Rys. 1-805. Zależność maksymalnej mocy strat od temperatury otoczenia